

越境する絶縁膜／半導体界面技術 ～ Si から Non-Si へ ～

日時：2015年9月14日（月）13:30～17:00
会場：4C

薄膜・表面物理分科会特別研究会「ゲートスタック研究会」が今年で20回の節目を数えました。この間、高誘電ゲート絶縁膜の研究開発を通じて絶縁膜の技術は飛躍的な発展を遂げ、Si基板以外の様々な半導体への応用が始まっています。本シンポジウムでは、 SiO_2/Si 界面、High-k/Si界面の研究で明らかにされた界面の諸問題を振り返りつつ、SiC、GaNなどNon-Si材料と絶縁膜の界面制御の課題を俯瞰的に検討します。

プログラム

- 13:30 白石 賢二（名大院工）“High-kゲートスタック開発を振り返って”
- 14:00 前田 辰郎（産総研）“High-mチャンネル材料と絶縁膜の界面制御”
- 14:30 鳥海 明（東大院工）“Ge-CMOSのための GeO_2/Ge 界面制御”
- 15:00～15:15 Break
- 15:15 木本 恒暢（京都大工）“SiCパワーデバイスの本格的実用化に向けたMOS界面の課題”
- 15:45 渡部 平司（阪大院工）“SiCパワーデバイス高性能化に向けたMOS界面設計と絶縁膜開発”
- 16:15 橋詰 保（北海道大学）“GaNパワーデバイスのためのMOS界面技術”
- 16:45 クロージング

奮ってご参加ください！